

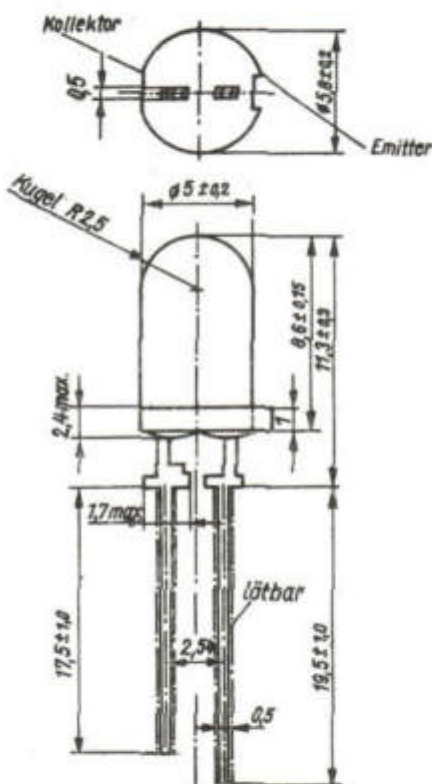
Fototransistor SP215

RFT

Si-npn-Planarfototransistor hoher Fotoempfindlichkeit in 5 mm - Allplast - Linsenverpackung.

Die Basis ist offen, die Steuerung erfolgt durch den Lichteinfall. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 215 ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IRED angepaßt.

Diese Type wurde vorwiegend für Standardanwendungen in IR-Lichtschranken, als hochempfindlicher Empfänger in der Konsumgüterelektronik, Spielwarenindustrie und Industrieelektronik konzipiert.



Kenndaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

	min.	max.	
Kollektor-Emitter-Dunkelstrom			
bei $E_e = 0 \text{ lx}$			
$U_{CE} = 25 \text{ V}$	I_{CEO}	- 100	nA
Kollektor-Emitterstrom			
bei $E_v = 1 \text{ klx}$			
$U_{CE} = 5 \text{ V}$	$I_{CE(H)}$		
ungruppiert	1,6	-	mA
SP 215 E	1,6	3,2	mA
SP 215 F	2,5	5,0	mA
SP 215 G	4,0	8,0	mA
SP 215 H	6,3	-	mA

Wellenlänge der max.

spektralen Empfindlichkeit	λ_{max}	850	nm
----------------------------	-----------------	-----	----

Spektraler Empfindlichkeitsbereich	$\Delta\lambda$	450 1050	nm
------------------------------------	-----------------	----------	----

Öffnungswinkel	θ	30 -	°
----------------	----------	------	---

Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	50	V
----------------------------	-----------	----	---

Masse: 0,33 g
Standard: TGL 42231

Schaltzeit

Impulsabfallzeit t_r

Impulsanstiegszeit t_f

für Gruppe E, F

für Gruppe G, H

und ungruppiert

10 μs

20 μs

Emitter-Kollektor-

Spannung

U_{ECO}

7

V

Betriebstemperatur-

bereich

ϑ_a

-40

85

$^{\circ}C$

Lagerungstemperatur-

bereich

ϑ_{stg}

5

35

$^{\circ}C$

für 1 Monat

ϑ_{stg}

-50

100

$^{\circ}C$

Gesamtverlust-

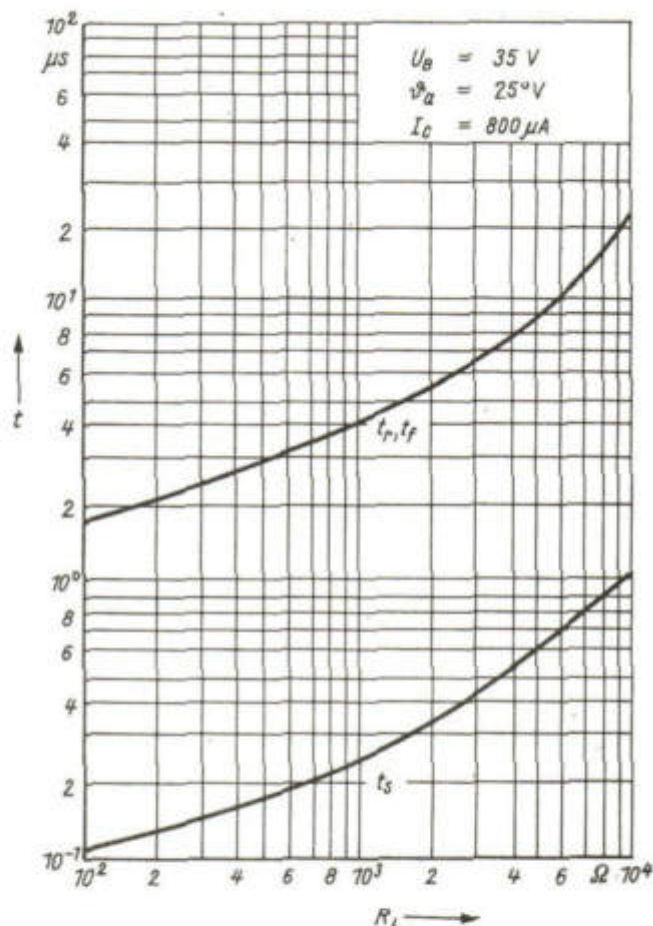
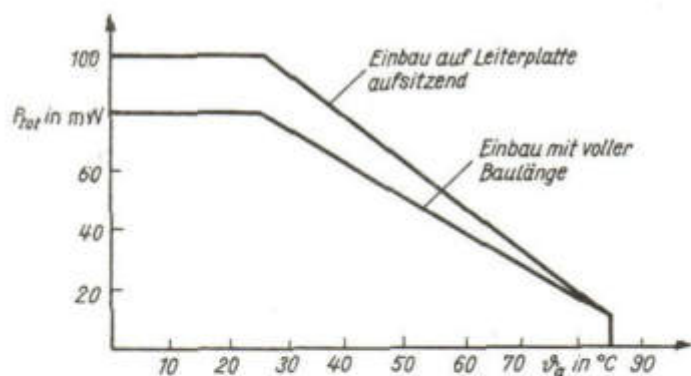
leistung bei

-40 ... +25 $^{\circ}C$

P_{tot}

100

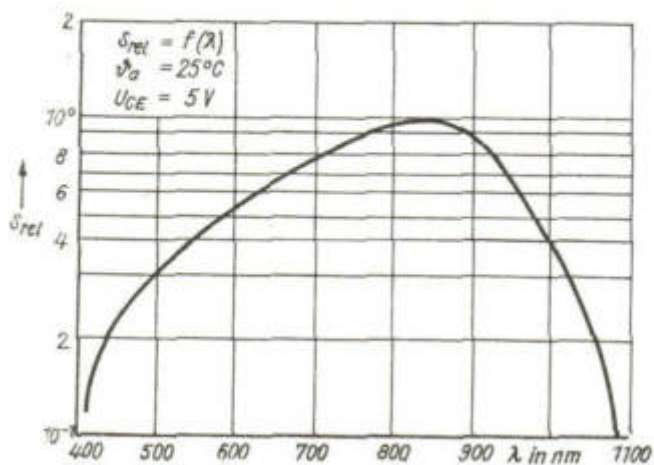
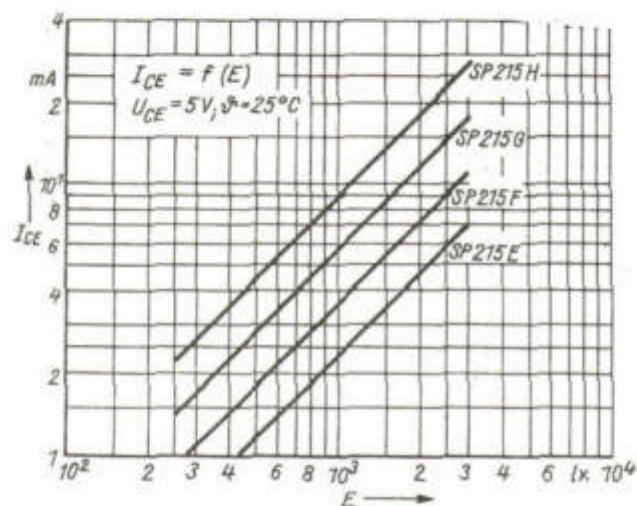
mW



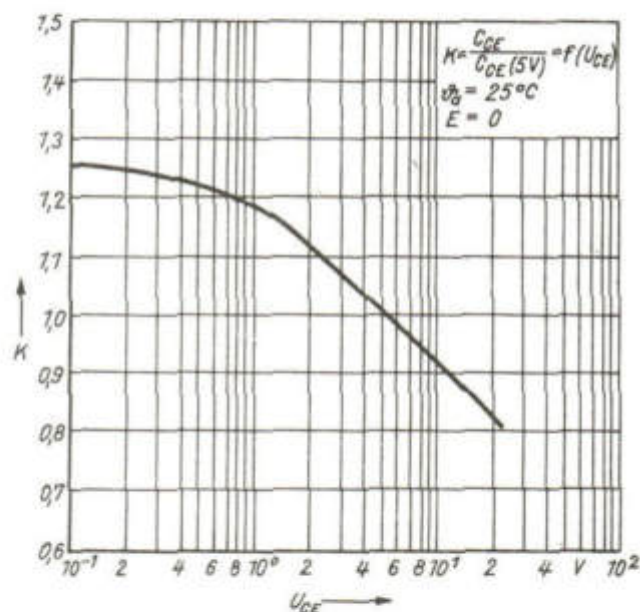
Anstiegszeit: t_r

Abfallzeit: t_f

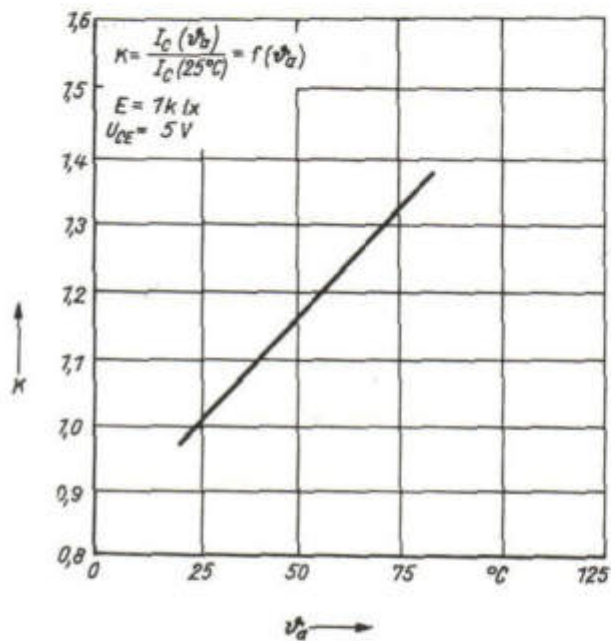
Speicherzeit: t_s



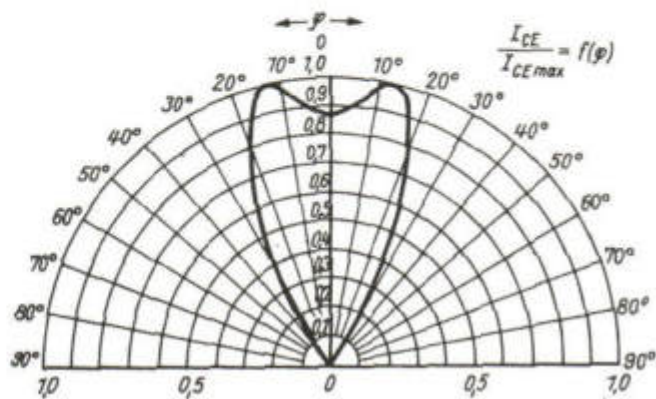
Relative spektrale Empfindlichkeit



Kollektor-Emitter-Kapazität



typischer normierter Fotostrom
in Abhängigkeit von ϑ_a



mittlere Empfangscharakteristik

Änderungen vorbehalten!
Redaktionsschluß Juni 1986

The logo consists of the letters 'RFT' in a bold, stylized font. The letters are composed of horizontal lines, giving it a striped appearance.

veb werk für fernsehelektronik berlin
im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße
Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik
export·import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Telex: BLN 114721 elei